

# Technische Information / Technical Information

**eupc**

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T 380 N 32...38**

N 

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^\circ C \dots T_{vj\ max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	3200 3600	3400 3800	V V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^\circ C \dots T_{vj\ max}$	$V_{DSM}$	3200 3600	3400 3800	V V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^\circ C \dots T_{vj\ max}$	$V_{RSM}$	3300 3700	3500 3900	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current		$I_{TRSMSSM}$		750	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^\circ C$ $T_C = 68^\circ C$	$I_{TAVM}$		380 480	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^\circ C, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{TSM}$		7200 6500	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^\circ C, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2t$		259500 211250	A <sup>2</sup> s A <sup>2</sup> s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f=50 \text{ Hz}, V_L = 10 \text{ V}, i_{GM} = 1 \text{ A}$ $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{cr}$		100	A/ $\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 5.Kennbuchstabe / 5th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$		1000	V/ $\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 1200 \text{ A}$	$V_T$	max.	2,8	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$		1,2	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$r_T$		1,2	m $\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ C, V_D = 6 \text{ V}$	$I_{GT}$	max.	250	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, V_D = 6 \text{ V}$	$V_{GT}$	max.	1,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6 \text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$I_{GD}$	max.	10	mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,25	mV
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ C, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \text{ W}$	$I_H$	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ C, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \text{ W}$ $i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$	$I_L$	max.	1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	$i_D, i_R$	max.	100	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ C$ $i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$t_{gd}$	max.	4,5	$\mu\text{s}$

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

**T 380 N 32...38**

**eupc**

N 

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutatet turn-off time	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_{TM}=I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100V, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 V/\mu s, -di_T/dt = 10 A/\mu s$ 4. Kennbuchstabe / 4th letter O	$t_q$	typ.	350	$\mu s$
---	---	-------	------	-----	---------

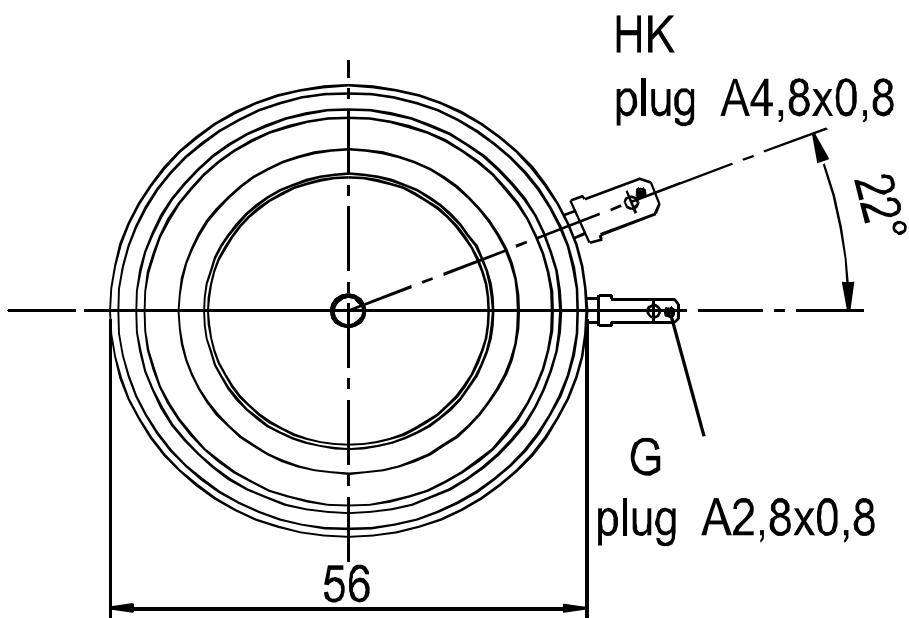
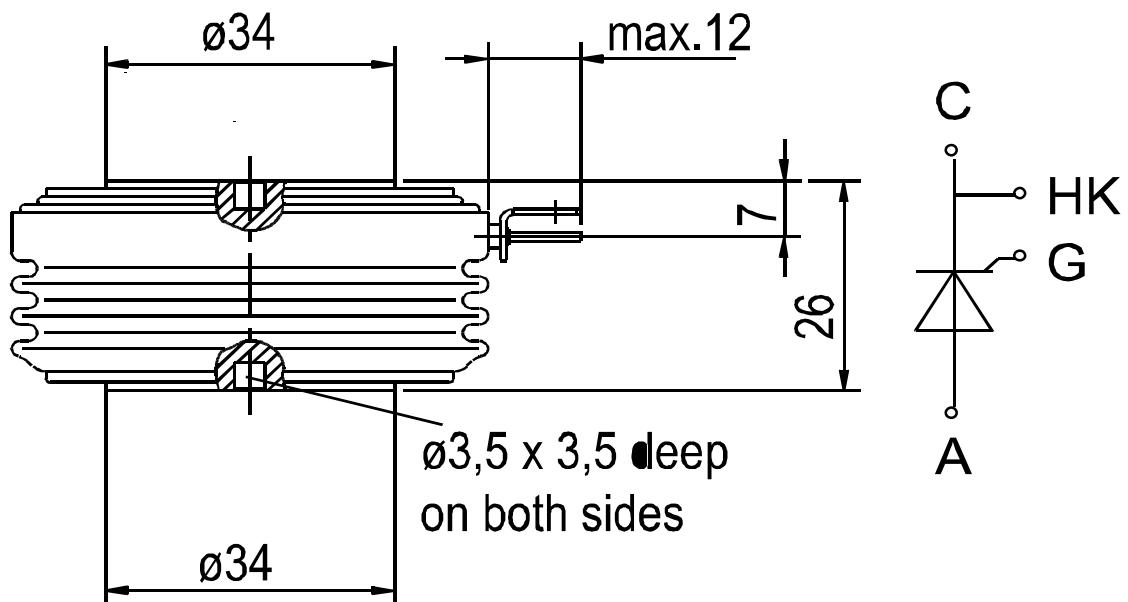
## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $Z=180^\circ\sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $Z=180^\circ\sin$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $Z=180^\circ\sin$ Kathode / cathode, DC	$R_{thJC}$	max. 0,0450 max. 0,0410 max. 0,0690 max. 0,0650 max. 0,1140 max. 0,1100	$^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$
Übergangs- Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	$R_{thCK}$	max. 0,0050 max. 0,0100	$^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \ max}$	125	$^{\circ}C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \ op}$	-40...125	$^{\circ}C$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40...150	$^{\circ}C$

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpreßkraft clamping force		F	7,5...17,5	kN
Gewicht weight		G	typ. 250	g
Kriechstrecke creepage distance			30	mm
Feuchteklassierung humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s <sup>2</sup>

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen./ This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor  
Phase Control Thyristor

T 380 N 32...38

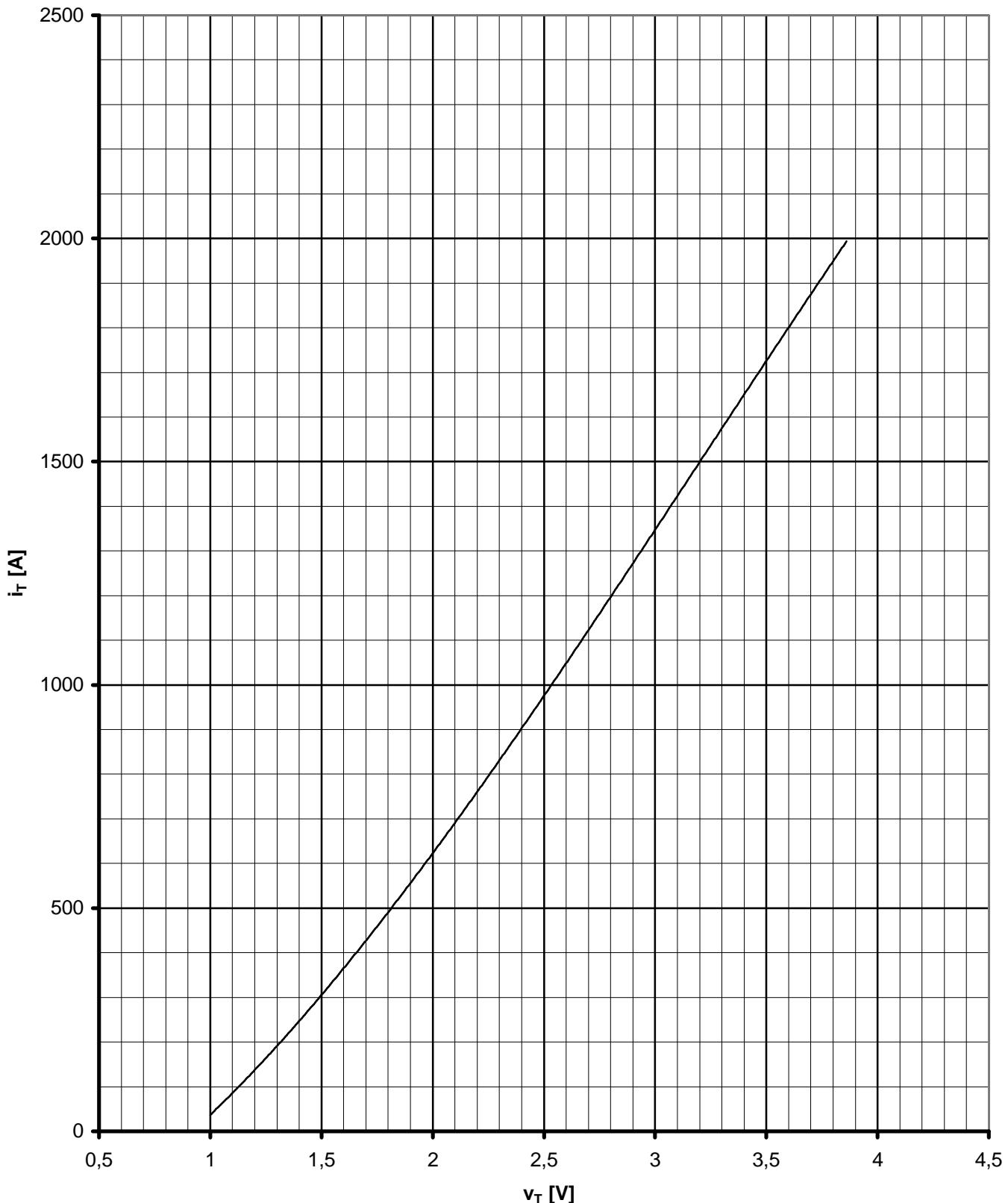
**eupc**

N

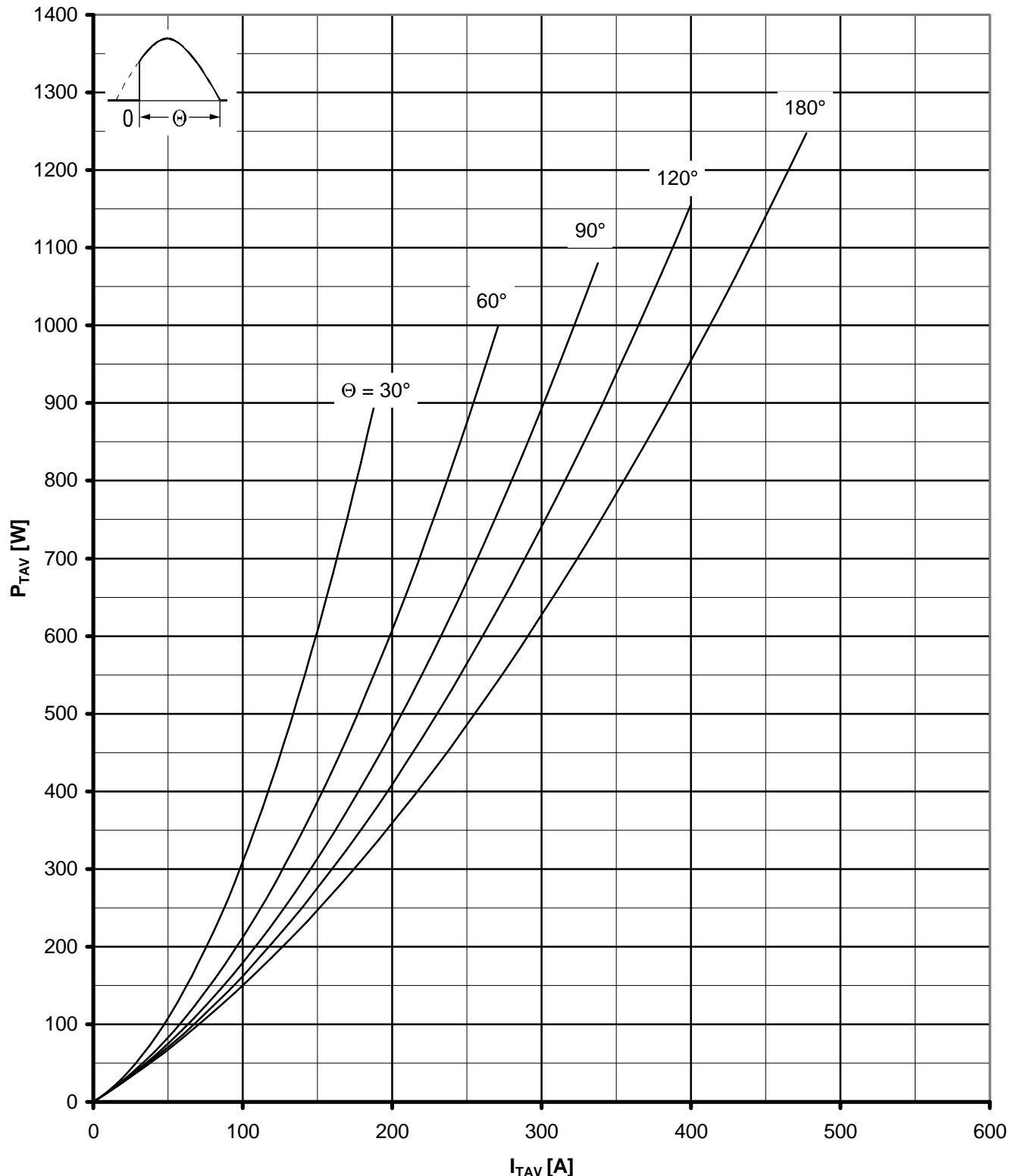


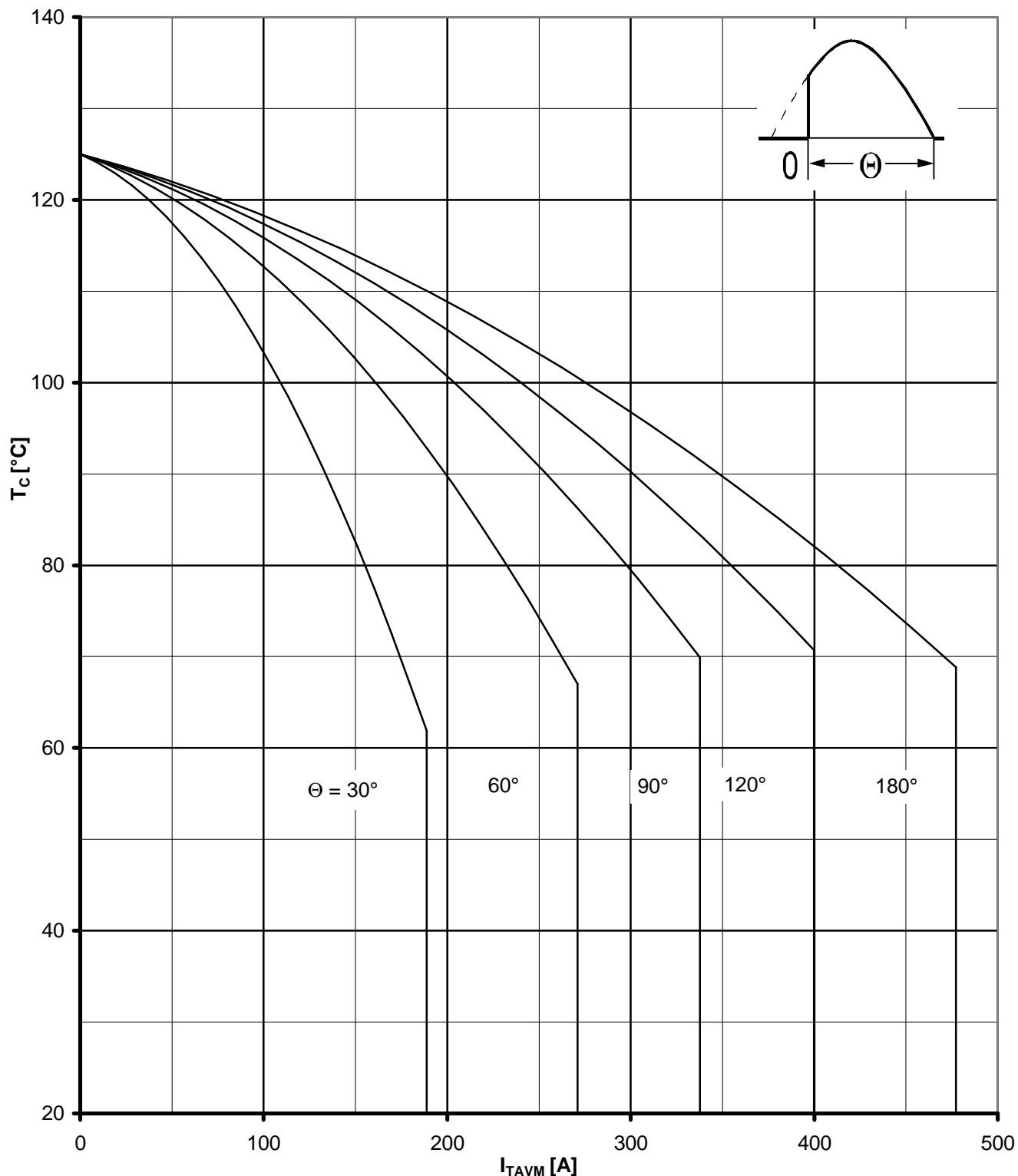
Kühlung cooling	Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes $Z_{thJC}$ für DC Analytical elements of transient thermal impedance $Z_{thJC}$ for DC							
	Pos.n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn}$ [°C/W]	0,00043	0,00557	0,019	0,016			
	$\tau_n$ [s]	0,00027	0,00221	0,085	0,36			
anodenseitig anode-sided	$R_{thn}$ [°C/W]	0,00034	0,00541	0,00486	0,0234	0,036		
	$\tau_n$ [s]	0,00024	0,0021	0,0376	0,158	2,47		
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn}$ [°C/W]	0,00026	0,00524	0,0132	0,0346	0,0468		
	$\tau_n$ [s]	0,00019	0,00192	0,0562	0,65	2,91		

Analytische Funktion / analytical function :  $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - \text{EXP}(-t/\tau_n))$



Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting On-state characteristic  $i_T=f(v_T)$   
 $T_{vj} = T_{vj \max}$

Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV}=f(I_{TAV})$ Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$



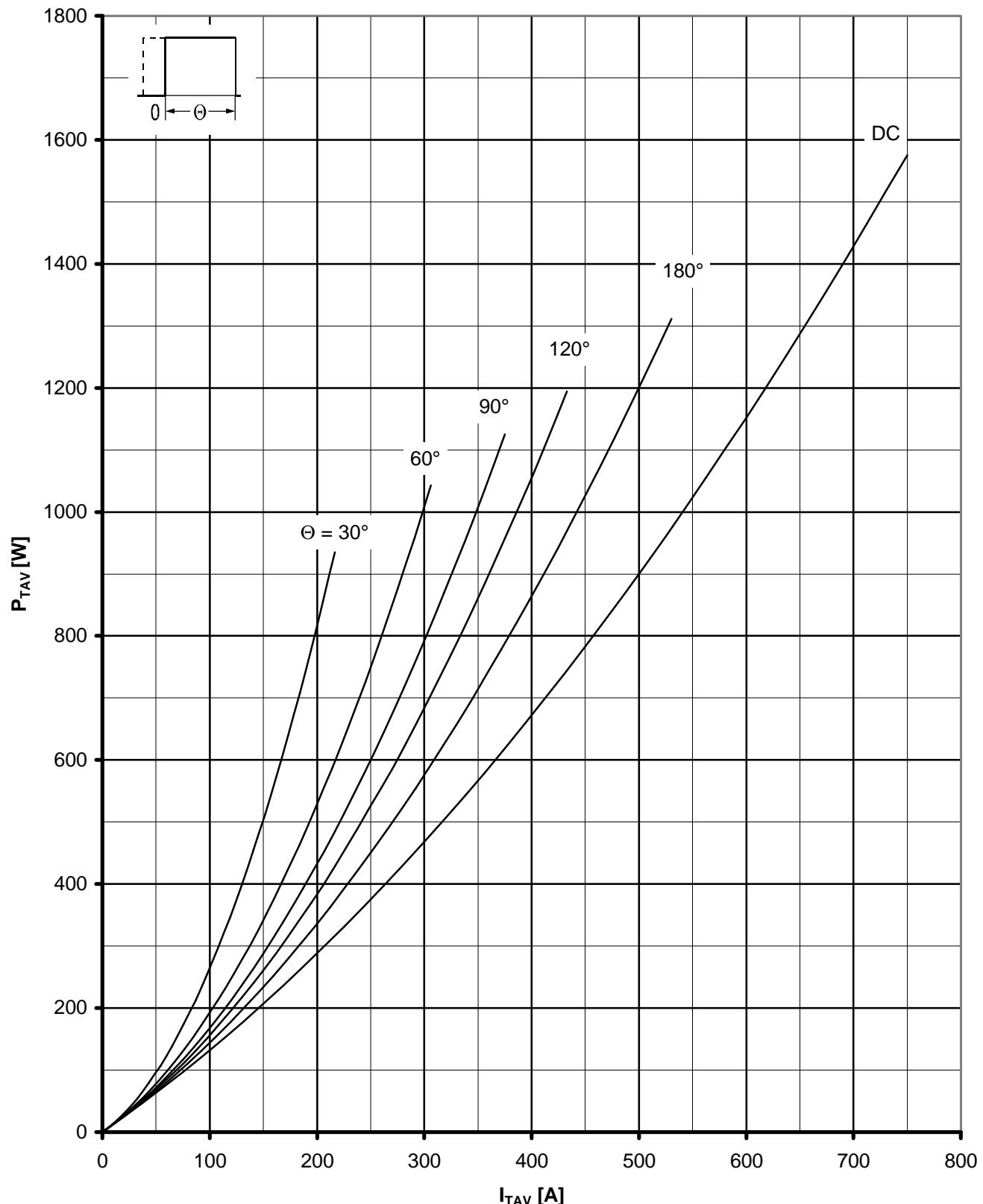
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c=f(I_{TAVM})$

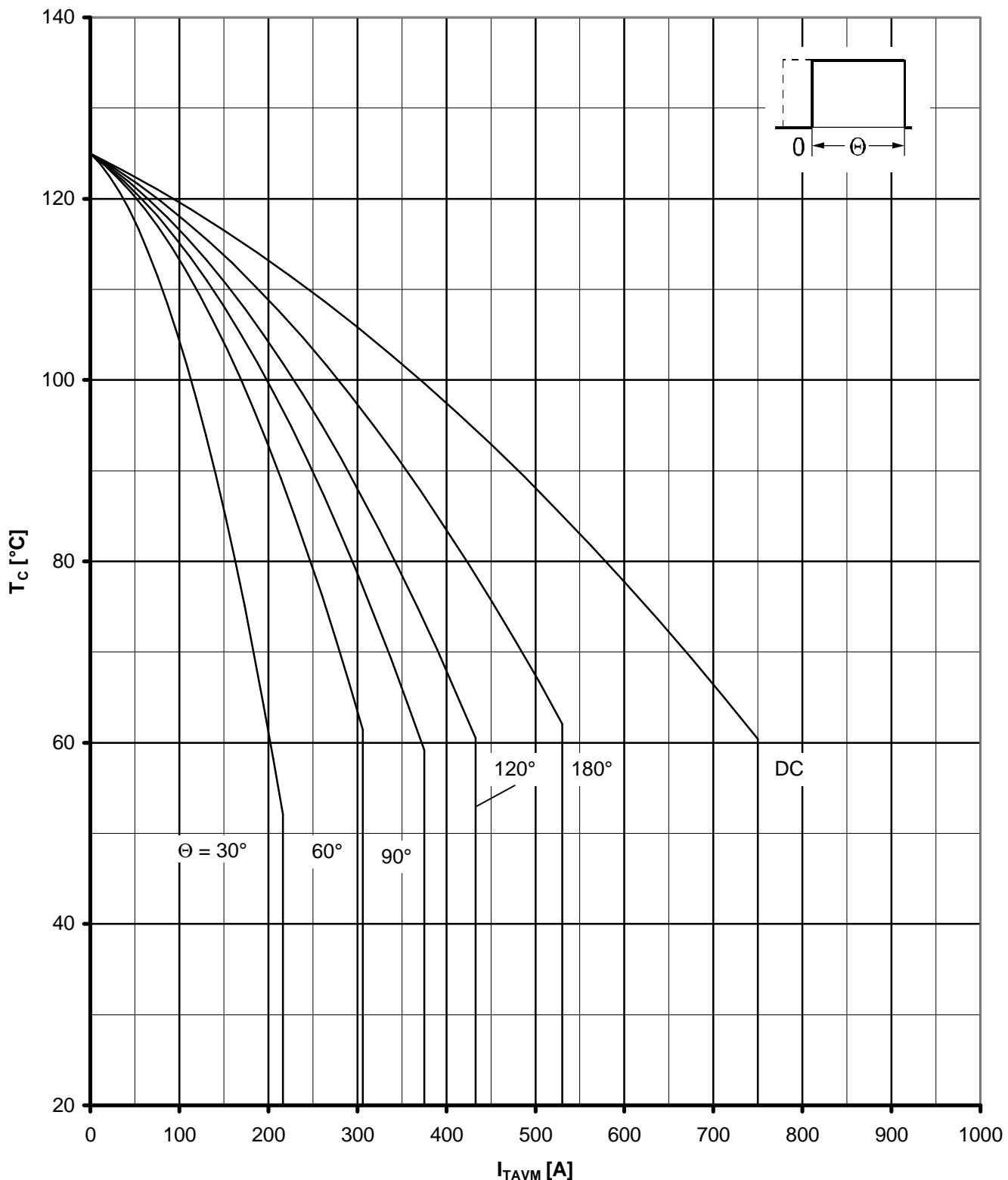
Beidseitige Kühlung / two sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$

**Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  (Schaltverluste gesondert berücksichtigen).**

**Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately).**

Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV}=f(I_{TAV})$ Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$



Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c=f(I_{TAVM})$

Beidseitige Kühlung / two sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel  $\Theta$  / current conduction angle  $\Theta$

**Berechnungsgrundlage  $P_{TAV}$  ( Schaltverluste gesondert berücksichtigen)**

**Calculation base  $P_{TAV}$  (switching losses should be considered separately)**